# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed

with this Office

Yoshiyuki OKUDA Q77775 LIGHT-EMISSION DRIVE CIRCUIT FOR ORGANIC ELECTROLUMINESCENCE... Date Filed: October 2, 2003

1 of 1

出願年月日 Date of Application:

2002年10月 3日

Darryl Mexic (202) 293-7060

出願番号

Application Number:

特願2002-291175

[ ST.10/C ]:

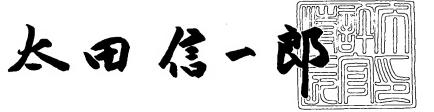
[JP2002-291175]

出 願 人
Applicant(s):

パイオニア株式会社

2003年 6月24日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office



### 特2002-291175

【書類名】

特許願

【整理番号】

56P0671

【提出日】

平成14年10月 3日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

G09G 3/30

【発明の名称】

有機エレクトロルミネッセンス素子の発光駆動回路及び

表示装置

【請求項の数】

17

【発明者】

【住所又は居所】

埼玉県鶴ヶ島市富士見6丁目1番1号 パイオニア株式

会社 総合研究所内

【氏名】

奥田 義行

【特許出願人】

【識別番号】

000005016

【氏名又は名称】 パイオニア株式会社

【代理人】

【識別番号】

100079119

【弁理士】

【氏名又は名称】

藤村 元彦

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

016469

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9006557

【プルーフの要否】

要

#### 【書類名】 明細書

【発明の名称】 有機エレクトロルミネッセンス素子の発光駆動回路及び表示装置

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 オン指令パルスに応じて導通状態となってデータ信号を通過させるスイッチ素子と、

前記スイッチ素子の導通中に前記スイッチ素子を通過した前記データ信号を保 持する容量性素子と、

前記容量性素子に保持された前記データ信号に応じて有機エレクトロルミネッセンス素子に順方向の駆動電流を供給して前記有機エレクトロルミネッセンス素子を発光させる駆動素子と、を備えたアクティブ駆動方式の発光駆動回路であって、

前記スイッチ素子は前記オン指令パルスが供給されたとき前記オン指令パルスと前記データ信号との電位差によって導通状態となるスイッチ用ダイオード素子からなることを特徴とする発光駆動回路。

【請求項2】 前記容量性素子は一端に前記オン指令パルスが供給され、

前記ダイオード素子は、一端にデータ信号が供給され、他端で前記容量性素子 の他端と接続され、

前記ダイオード素子が導通状態から非導通状態に変化したとき前記オン指令パルスの振幅値だけ前記容量性素子の前記ダイオード素子との接続点の電位が変化し、前記スイッチ素子の導通時における前記接続点の電位に応じて前記駆動素子が導通状態となって前記駆動電流を前記有機エレクトロルミネッセンス素子に供給することを特徴とする請求項1記載の発光駆動回路。

【請求項3】 前記ダイオード素子は有機ダイオード素子であることを特徴とする請求項1記載の発光駆動回路。

【請求項4】 前記オン指令パルスの発生直前にリセットパルスを前記接続点に供給して前記接続点の電位を第1所定の電位まで変化させるリセット回路を有することを特徴とする請求項2記載の発光駆動回路。

【請求項5】 前記リセット回路はダイオード素子からなることを特徴とす

る請求項4記載の発光駆動回路。

• • •

【請求項6】 前記容量性素子と前記スイッチ用ダイオード素子との間に挿入され、前記スイッチ用ダイオード素子の非導通時に前記容量性素子と前記スイッチ用ダイオード素子との接続を遮断するクロストーク防止回路を有することを特徴とする請求項2記載の発光駆動回路。

【請求項7】 前記クロストーク防止回路は、前記容量性素子と前記スイッチ用ダイオード素子との間に前記スイッチ用ダイオードと同一の極性方向にて挿入された第1ダイオード素子と、前記スイッチ用ダイオード素子と前記第1ダイオード素子と接続点に一端が接続され前記スイッチ用ダイオード素子の非導通時に導通状態となって前記スイッチ用ダイオード素子と前記第1ダイオード素子との接続点に第2所定の電位を与えて前記第1ダイオードを非導通状態にさせる第2ダイオード素子とからなることを特徴とする請求項6記載の発光駆動回路。

【請求項8】 前記第2ダイオードの他端は前記容量性素子の一端と同一ラインに接続されていることを特徴とする請求項7記載の発光駆動回路。

【請求項9】 互いに交差する複数のデータ線及び複数の走査線による複数の交差位置毎に配置された1組の有機エレクトロルミネッセンス素子及びアクティブ駆動方式の発光駆動回路を有する表示パネルと、

前記複数の走査線のうちから1の走査線に所定のタイミングで順番に走査パルスを供給し、前記複数のデータ線のうちから前記1の走査線上の発光させるべき 有機エレクトロルミネッセンス素子に対応するデータ線にデータ信号を供給する 制御手段と、を備えた表示装置であって、

前記発光駆動回路は、前記走査パルスが供給されたとき前記走査パルスと前記 データ信号との電位差によって導通状態となるスイッチ用ダイオード素子と、

前記ダイオード素子の導通中に前記ダイオード素子を通過した前記データ信号 を保持する容量性素子と、

前記容量性素子に保持された前記データ信号に応じて前記有機エレクトロルミネッセンス素子に順方向の駆動電流を供給して前記有機エレクトロルミネッセンス素子を発光させる駆動素子と、からなることを特徴とする表示装置。

【請求項10】 前記容量性素子は一端に前記走査パルスが供給され、

前記スイッチ用ダイオード素子は、一端に前記データ信号が供給され、他端で 前記容量性素子の他端と接続され、

. . '

前記スイッチ用ダイオード素子が導通状態から非導通状態に変化したとき前記 走査パルスの振幅値だけ前記容量性素子の前記第1ダイオード素子との接続点の 電位が変化し、前記スイッチ用ダイオード素子の導通時における前記接続点の電 位に応じて前記駆動素子が導通状態となって前記駆動電流を前記有機エレクトロ ルミネッセンス素子に供給することを特徴とする請求項9記載の表示装置。

【請求項11】 前記スイッチ用ダイオード素子は有機ダイオード素子であることを特徴とする請求項9記載の表示装置。

【請求項12】 前記走査パルスの発生直前にリセットパルスを前記接続点に供給して前記接続点の電位を第1所定の電位まで変化させるリセット回路を有することを特徴とする請求項10記載の表示装置。

【請求項13】 前記リセット回路はダイオード素子からなることを特徴と する請求項12記載の表示装置。

【請求項14】 前記リセットパルスは1走査前の前記走査パルスであることを特徴とする請求項12記載の表示装置。

【請求項15】 前記容量性素子と前記スイッチ用ダイオード素子との間に 挿入され、前記スイッチ用ダイオード素子の非導通時に前記容量性素子と前記ス イッチ用ダイオード素子との接続を遮断するクロストーク防止回路を有すること を特徴とする請求項10記載の表示装置。

【請求項16】 前記クロストーク防止回路は、前記容量性素子と前記スイッチ用ダイオード素子と間に前記スイッチ用ダイオードと同一の極性方向にて挿入された第1ダイオード素子と、前記スイッチ用ダイオード素子と前記第1ダイオード素子と接続点に一端が接続され前記スイッチ用ダイオード素子の非導通時に導通状態となって前記スイッチ用ダイオード素子と前記第1ダイオード素子との接続点に第2所定の電位を与えて前記第1ダイオードを非導通状態にさせる第2ダイオード素子とからなることを特徴とする請求項15記載の表示装置。

【請求項17】 前記第2ダイオードの他端は前記容量性素子の一端と同一 ラインに接続されていることを特徴とする請求項16記載の表示装置。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明が属する技術分野】

本発明は、有機エレクトロルミネッセンス素子の発光駆動回路及び表示装置に関する。

[0002]

【従来の技術】

容量性発光素子の1つである有機エレクトロルミネッセンス素子(以下、単に有機EL素子という)をマトリックス状に配置した表示パネルは既に知られている。有機EL素子による表示パネルをアクティブ駆動する方式の表示装置は、各画素毎に図1に示すような構成の発光駆動回路を有している。

[0003]

図1に示した1画素分の発光駆動回路は、EL素子5を駆動するために、2つのFET (Field Effect Transistor)1,2及びコンデンサ3を有している。FET1はデータ書き込み用であり、そのゲートGは、走査パルスが供給される走査線Yiに接続され、FET1のソースSはデータ信号が供給されるデータ線Xjに接続されている。FET1のドレインDはFET2のゲートGに接続され、コンデンサ3の一方の端子に接続されている。FET2はEL素子5に駆動電流を供給するための駆動用であり、そのソースSはコンデンサ3の他方の端子と共に共通のアース線6に接続されている。FET2のドレインDはEL素子5の陽極に接続され、EL素子5の陰極には電源(図示せず)の出力電圧Veeが負電位として供給される。

[0004]

かかる発光駆動回路の動作について述べると、先ず、FET1のゲートGに走査線Yiを介して走査パルスが供給されると、FET1はオンとなり、そのソースSにデータ線Xjを介して供給されるデータ信号の電圧に対応した電流をソースSからドレインDへ流す。FET1のオン電圧の期間にコンデンサ3は充電され、その充電電圧がFET2のゲートGに供給されて、FET2はオン状態(能動状態又は飽和状態)となる。FET2のオンにより、EL素子5には順方向に

発光開始電圧以上の電圧が印加され、アース線6から駆動電流がFET2のソースS・ドレインD間、そしてEL素子5を流れてEL素子5を発光せしめる。また、FET1のゲートGへの走査パルスの供給が無くなると、FET1はオープン状態となり、FET2はコンデンサ3に蓄積された電荷によりゲートGの電圧が保持され、次の走査まで駆動電流を維持し、EL素子5の発光も維持される。

[0005]

. . '

## 【発明が解決しようとする課題】

上記したように従来の表示装置の発光駆動回路においては、データ線からのデ ータ信号をコンデンサに書き込むためのFET1として、有機半導体をチャンネ ル材料にしたMOS-FETによるスイッチ素子が一般的に用いられている。こ のようなMOS-FETを用いたスイッチ素子ではオン時に流れる電流を、表示 パネルで一般的な低温ポリシリコンTFTで流せる程度まで大きくしようとする と、MOS-FET自体を大きくする必要がある。また、MOS-FETを大き くすると、MOS-FETのゲート・ドレイン間の寄生容量が比例して大きくな る。このゲート・ドレイン間寄生容量があると、ドレイン・ソース間オン電流以 外に、ゲートに印加されたオンオフ制御パルス信号電圧が、ゲート・ドレイン間 寄生容量を通じて、微分された形で充電・放電電流となって、データ保持コンデ ンサへ流入し、本来のコンデンサの蓄電電圧を変化させてしまう。この現象は、 一般のポリシリコン系材料によるTFTでも見られるものであるが、有機半導体 材料の場合にはキャリア移動度が一般のポリシリコン系材料より極端に低いため 、ドレイン・ソース電流が相対的に低下して、ドレイン・ソース間寄生容量によ る誘導電流との比が悪化することにより、顕在化して動作に支障を来す程度にな るのである。この結果、FET2のゲートには予め定められた所望の輝度に対応 した電圧が印加されず、EL素子5の発光輝度を変化させてしまうという問題点 があった。

[0006]

そこで、本発明の目的は、データ保持用コンデンサ保持電圧が書き込み動作によって攪乱されずにデータ信号に応じた輝度で有機EL素子を発光させることができるアクティブ駆動方式の発光駆動回路及び表示装置を提供することである。

[0007]

## 【課題を解決するための手段】

本発明の有機EL素子の発光駆動回路は、オン指令パルスに応じて導通状態となってデータ信号を通過させるスイッチ素子と、スイッチ素子の導通中にスイッチ素子を通過したデータ信号を保持する容量性素子と、容量性素子に保持されたデータ信号に応じて有機エレクトロルミネッセンス素子に順方向の駆動電流を供給して有機エレクトロルミネッセンス素子を発光させる駆動素子と、を備えたアクティブ駆動方式の発光駆動回路であって、スイッチ素子はオン指令パルスが供給されたときオン指令パルスとデータ信号との電位差によって導通状態となるスイッチ用ダイオード素子からなることを特徴としている。

#### [0008]

本発明の表示装置は、互いに交差する複数のデータ線及び複数の走査線による 複数の交差位置毎に配置された1組の有機エレクトロルミネッセンス素子及びア クティブ駆動方式の発光駆動回路を有する表示パネルと、複数の走査線のうちか ら1の走査線に所定のタイミングで順番に走査パルスを供給し、複数のデータ線 のうちから1の走査線上の発光させるべき有機エレクトロルミネッセンス素子に 対応するデータ線にデータ信号を供給する制御手段と、を備えた表示装置であっ て、発光駆動回路は、走査パルスが供給されたとき走査パルスとデータ信号との 電位差によって導通状態となるスイッチ用ダイオード素子と、ダイオード素子の 導通中にダイオード素子を通過したデータ信号を保持する容量性素子と、容量性 素子に保持されたデータ信号に応じて有機エレクトロルミネッセンス素子に順方 向の駆動電流を供給して有機エレクトロルミネッセンス素子を発光させる駆動素 子と、からなることを特徴としている。

[0009]

## 【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施例を図面を参照しつつ詳細に説明する。

図2は本発明によるマトリックス表示パネルを用いた表示装置を示している。 この表示装置は、表示パネル11、走査パルス供給回路12、データ信号供給回路13、及びコントローラ15を備えている。

## [0010]

表示パネル11は、m×n個の画素からなるアクティブマトリックス型のものであり、図2に示したように画素毎にEL発光駆動回路11<sub>1,1</sub>~11<sub>m,n</sub>を有している。EL発光駆動回路11<sub>1,1</sub>~11<sub>m,n</sub>は、全て同一の構成を有し、走査線Y1~Ynを介して走査パルス供給回路12に接続され、データ線X1~Xmを介してデータ信号供給回路13に接続されている。コントローラ15は入力される画像データに応じて走査制御信号及びデータ制御信号を生成する。走査制御信号はY転送クロック信号及びY転送パルスからなり、走査パルス供給回路12に供給される。データ制御信号はX転送クロック信号、X転送パルス及び直列なm個分(mビット)のデータ信号からなり、データ信号供給回路13に供給される。X転送クロック信号はY転送クロック信号より高い周波数のクロックであり、Y転送クロック信号の1クロック分の期間内にX転送クロック信号はmクロック分を生成する。

### [0011]

## [0012]

応じてX転送パルスをシフトレジスタ $13_1$ から順次シフトレジスタ $13_m$ に向けて転送する構成を有している。シフトレジスタ $13_1$ ,  $13_2$ , ……,  $13_m$ の各出力は対応するサンプルホールド回路 $14_1$ ,  $14_2$ , ……,  $14_m$ に接続されている。シフトレジスタ $13_1$ ,  $13_2$ , ……,  $13_m$ 各々はX転送パルスが転送されたときにはそのX転送パルスを対応するサンプルホールド回路に出力する。サンプルホールド回路 $14_1$ ,  $14_2$ , ……,  $14_m$ 各々においてはコントローラ15から上記したm個分のデータ信号がライン16を介して供給され、対応するシフトレジスタからX転送パルスが供給されたときにデータ信号の1ビット分が保持され、対応するデータ線(X1~Xm0いずれか1)に対してその保持データ信号が出力される。

#### [0013]

発光駆動回路 1 1<sub>1,1</sub>は、図4に示すように有機 E L素子 2 5 を駆動するために、FET 2 1、有機ダイオード 2 2 及びコンデンサ 2 3 を有している。コンデンサ 2 3 の一端は走査パルス供給回路 1 2 から走査パルスが供給される走査線 Y 1 に接続され、有機ダイオード 2 2 のアノードはデータ信号が供給されるデータ線 X 1 に接続されている。有機ダイオード 2 2 のカソードとコンデンサ 2 3 の他端とは互いに接続され、更にFET 2 1 のゲートに接続されている。FET 2 1 のソースはアースされ、ドレインは有機 E L素子 2 5 の陽極に接続されている。 E L素子 2 5 の陰極には電源(図示せず)の出力電圧 Veeが供給される。

### [0014]

れ、そのデータ信号のレベルによってダイオード22がオンしてその電位レベルがコンデンサ23の他端に印加される。データ信号の電位レベルは0Vより大である。コンデンサ23の他端の電位Vgはデータ信号の電位レベルによって、コンデンサ23は充電され、そのときのデータ信号の電位レベルにほぼ等しいレベルとなる。ダイオード22がオンにあるときの電位VgはFET21のゲートに印加されるが、そのときの電位VgではFET21はオフ状態である。

### [0015]

走査パルスによる書き込み期間が終了すると、発光駆動回路11<sub>1,1</sub>は保持期間となり、走査線Y1の電位は0VからVaとなるので、コンデンサ23は蓄積された電荷を保持し、コンデンサ23の他端の電位Vgは図5(c)に示すように、書き込み終了時点の保持レベルがVaだけ上昇する。ダイオード22は逆バイアスとなるのでオフとなる。一方、Vaだけ上昇した電位Vgがゲートに印加されるFET21は電位Vgのレベルに応じたオン状態(能動状態を含む)となる。よって、有機EL素子25にはそのFET21の導通状態に応じた駆動電流が流れ、有機EL素子25は発光する。その発光輝度は駆動電流の値に対応する。

## [0016]

## [0017]

走査パルスによる書き込み期間が終了すると、発光駆動回路 1 1<sub>1,1</sub>は保持期間となり、走査線 Y 1 の電位は V a から 0 V となるので、コンデンサ 2 3 は蓄積された電荷を保持し、コンデンサ 2 3 の他端の電位 V g は図 7 (c)に示すように、書き込み終了時点の保持レベルが V a だけ降下する。ダイオード 2 2 は逆バイアスとなるのでオフとなる。一方、 V a だけ降下した電位 V g がゲートに印加される F E T 2 1 は電位 V g のレベルに応じたオン状態(能動状態を含む)となる。よって、有機 E L 素子 2 5 にはその F E T 2 1 の導通状態に応じた駆動電流が流れ、有機 E L 素子 2 5 は発光する。その発光輝度は駆動電流の値に対応する。

## [0018]

なお、図5及び図7においてΔVgはコンデンサ23の充放電及びFET21のオンオフによって電位Vgが変化し得る範囲である。この範囲となるようにVaを考慮してデータ信号レベルを予め定めておき、書き込み時のデータ信号のレベルを変化させることにより有機EL素子25の駆動電流が変化し、その結果、発光輝度を変化させることができる。

#### [0019]

上記した各実施例の如く、データ信号書き込み用のスイッチ素子として、有機ダイオード素子を用いることにより、従来の表示装置で有機MOS-FETを用いた発光駆動回路に比べてデータ信号の書き込み速度の高速化を図ることができ、ビデオ信号に応じた動画映像にも対応することができる。また、ダイオード素子は小さい面積で大電流を流すことができるので、ダイオード素子の浮遊容量が小さくなり、オンオフのエッジ時のパルス波形の変形によるコンデンサへの漏れを減少させることができる。よって、EL素子の発光輝度の攪乱を防止することができる。

## [0020]

図8は本発明の他の実施例として表示装置を示している。この表示装置は、表示パネル31、走査パルス供給回路32、データ信号供給回路33、及びコントローラ35を備えている。走査線がY0~Ynとなっている点が図2の表示装置と異なる部分である。図8の装置の走査パルス供給回路32には走査線Y0分だ

けシフトレジスタが多く設けられている。

## [0021]

図8の表示装置における表示パネル31の発光駆動回路3 $1_{1,1}$ ~3 $1_{m,n}$ は全て同一構成であるので、図9においては3つの発光駆動回路3 $1_{1,1}$ ~3 $1_{1,3}$ の構成を示している。

発光駆動回路 3 1 1,1は、図9に示すように有機 E L 素子 4 5 を駆動するために、F E T 4 1、有機ダイオード 4 2, 4 3 及びコンデンサ 4 4 を有している。有機ダイオード 4 2 はデータ書き込み用であり、有機ダイオード 4 3 はリセット用である。有機ダイオード 4 2 のアノードはデータ線 X 1 に接続され、カソードは有機ダイオード 4 3 のアノードに接続されている。有機ダイオード 4 3 のカソードは走査線 Y 0 に接続されている。コンデンサ 4 4 の一端は走査線 Y 1 に接続され、他端は有機ダイオード 4 2, 4 3 の共通接続ラインと共にF E T 4 1 のゲートに接続されている。F E T 4 1 のソースはアースされ、ドレインは有機 E L 素子 4 5 の陽極に接続されている。E L 素子 4 5 の陰極には電源(図示せず)の出力電圧 V e e が供給される。

#### [0022]

## [0023]

次に、走査パルス供給回路 32から走査線 Y0への走査パルスの供給が停止すると、走査線 Y0の電位は Vaとなるので、有機ダイオード 43はオフとなる。その後、走査パルス供給回路 32 からは走査線 Y1 を介して走査パルスがコンデンサ 44 の一端に供給される。この走査パルスはコンデンサ 44 へのデータ信号の書き込みを行うためのアドレス信号であり、走査線 Y1 は図 10(b) に示すように書き込み期間以外には電位 Va であるが、書き込み期間に走査パルスによって0 V となる。その書き込み期間に図 10(c) に示す如きデータ信号がデータ線 X1 を介してダイオード 42 のアノードに供給され、そのデータ信号の電位レベルによってダイオード 42 がオンしてその電位レベルがコンデンサ 44 の他端に印加される。コンデンサ 44 の他端の電位 Vg は図 10(d) に示すように変化する。すなわち、データ信号の電位レベルによってコンデンサ 44 は充電され、電位 Vg はそのときのデータ信号の電位レベルにほぼ等しいレベルとなる。ダイオード 42 がオンにあるときの電位 Vg は FET41 のゲートに印加されるが、そのときの電位 Vg では Vg では Vg では Vg では Vg に Vg では V

## [0024]

走査線Y1の走査パルスは発光駆動回路 $31_{1,2}$ にはリセット信号として供給される。上記した発光駆動回路 $31_{1,1}$ のリセット動作と同様に発光駆動回路 $31_{1,2}$ においてリセット動作が行われる。

走査線Y1を介した走査パルスによる書き込み期間が終了すると、発光駆動回路 31 $_{1,1}$ は保持期間となり、走査線Y1の電位は0VからVaとなるので、コンデンサ44は蓄積された電荷を保持し、コンデンサ44の他端の電位Vgは図10(d)に示すように、書き込み終了時点の保持レベルがVaだけ上昇する。ダイオード42は逆バイアスとなるのでオフとなる。一方、Vaだけ上昇した電位Vgがゲートに印加されるFET41は電位Vgのレベルに応じたオン状態(能動状態を含む)となる。よって、有機EL素子45にはそのFET41の導通状態に応じた駆動電流が流れ、有機EL素子45は発光する。その発光輝度は駆動電流の値に対応する。

## [0025]

図9に示した有機ダイオード42、43は、図11に示すように極性を逆にして設けても良い。図11の構成においては、走査パルスが供給されたきにはその走査線はVaの電位となり、それ以外の走査線はVaの電位となる。発光駆動回路311,1には先ず、走査線V0からの走査パルスはリセット信号として供給される。このリセット信号は図12(a)に示すようにVaであるので、VET41のゲート電位Vgが保持期間においてによって範囲Vgの最高レベルでないならば、有機ダイオード43がオンとなる。これによってゲート電位Vgは図12(d)に示すように範囲Vgの最高レベルとなる。これによって発光駆動回路311,1ではリセットが行われたこととなる。その後の動作については図6に示した発光駆動回路11,1の動作と同様である。

## [0026]

発光駆動回路 3 1 1,1は、図13に示すように有機 E L素子45を駆動するために、FET41、有機ダイオード42,43,46,47及びコンデンサ44を有している。有機ダイオード46,47が図9の回路から更に加わっている。有機ダイオード42のアノードはデータ線 X1に接続され、カソードは有機ダイオード46のカソード及び有機ダイオード47のアノードに接続されている。有機ダイオード47のカソードは有機ダイオード43のアノードに接続されている。有機ダイオード43のカソードは走査線 Y0に接続されている。有機ダイオード43のアノードはコンデンサ44の一端と共に走査線 Y1に接続されている。コンデンサ44の他端は有機ダイオード43,47の共通接続ラインと共にFET41のゲートに接続されている。FET41のソースはアースされ、ドレインは有機 E L素子45の陽極に接続されている。E L素子45の陰極には電源(図示せず)の出力電圧 Veeが供給される。

#### [0027]

図13においても発光駆動回路31 $_{1,2}$ , 31 $_{1,3}$ は発光駆動回路31 $_{1,1}$ と同一の構成を有し、発光駆動回路31 $_{1,2}$ は走査線Y1, Y2とデータ線X1とに

接続され、発光駆動回路  $31_{1,3}$ は発光駆動回路  $31_{1,1}$ は走査線 Y2, Y3とデータ線 X1とに接続されている。

図13の発光駆動回路3 $1_{1,1}$ において、リセット期間及び書き込み期間の動作は図9に示した発光駆動回路3 $1_{1,1}$ とほぼ同一である。すなわち、先ず、走査線Y0からの走査パルスはリセット信号として供給される。このリセット信号は図14(a)に示すように0Vであるので、FET41のゲート電位Vgが保持期間において範囲 $\Delta V$ gの最低レベルでないならば、有機ダイオード43がオンとなる。このオンによってゲート電位Vgは範囲 $\Delta V$ gの最低レベルとなる。よって、発光駆動回路3 $1_{1,1}$ ではリセットが行われたこととなる。

## [0028]

次に、走査パルス供給回路32から走査線Y0への走査パルスの供給が停止すると、走査線Y0の電位はVaとなるので、有機ダイオード43はオフとなる。その後、走査パルス供給回路32からは走査線Y1を介して走査パルスがコンデンサ44の一端に供給される。この走査パルスはコンデンサ44へのデータ信号の書き込みを行うためのアドレス信号であり、図14(b)に示すように書き込み期間以外には電位Vaであるが、書き込み期間に0Vとなる。その書き込み期間に図14(c)に示す如きデータ信号がデータ線X1を介してダイオード42のアノードに供給され、そのデータ信号の電位レベルによって直列接続のダイオード42及びダイオード47が各々オンしてその電位レベルがコンデンサ44の他端に印加される。このときダイオード46はオフである。コンデンサ44の他端の電位Vgはデータ信号の電位レベルによって、コンデンサ44は充電され、そのときのデータ信号の電位レベルにほぼ等しいレベルとなる。ダイオード42及びダイオード47がオンにあるときの電位VgはFET41のゲートに印加されるが、そのときの電位VgではFET41はオフ状態である。

### [0029]

走査線Y1の走査パルスは発光駆動回路 $31_{1,2}$ にはリセット信号として供給される。上記した発光駆動回路 $31_{1,1}$ のリセット動作と同様に発光駆動回路 $31_{1,2}$ においてリセット動作が行われる。

走査線Y1を介した走査パルスによる書き込み期間が終了すると、発光駆動回

路 $31_{1,1}$ は保持期間となり、走査線Y1の電位は0VからVaとなるので、コンデンサ44は蓄積された電荷を保持し、コンデンサ44の他端の電位Vgは図14(d)に示すように、書き込み終了時点の保持レベルがVaだけ上昇する。ダイオード42及びダイオード47は逆バイアスとなるのでオフとなる。一方、Vaをけ上昇した電位Vgがゲートに印加されるFET41は電位Vgのレベルに応じたオン状態(能動状態を含む)となる。よって、有機EL素子45にはそのFET41の導通状態に応じた駆動電流が流れ、有機EL素子45は発光する。その発光輝度は駆動電流の値に対応する。

[0030]

この保持期間においては、ダイオード46はダイオード42とダイオード47 との接続点Pの電位に応じてオンとなる。ダイオード46のオンとによって接続 点Pの電位は図14(d)に示すように固定され、ほぼVaとなる。これによって ダイオード47は逆バイアスとなりオフ状態のままとなるので、データ線X1の データ信号が走査中の他の発光駆動回路のためにレベル変動しても、その変動が ダイオード42のオフ時の浮遊容量によって電位Vgのレベルに影響を与えるこ とがなくなり、クロストークを防止することができる。

[0031]

図13に示した有機ダイオード42,43,46,47は、図15に示すように極性を逆にして設けても良い。図15の発光駆動回路 $31_{1,1}$ ~ $31_{m,n}$ の動作は図13に示した発光駆動回路 $11_{1,1}$ の動作と同様に、ダイオード46は保持期間にダイオード42とダイオード47との接続点Pの電位に応じてオンとなり、ダイオード42とダイオード47との接続点Pの電位が図16(d)に示すように固定される。よって、ダイオード42のオフ時の浮遊容量によるクロストークを防止することができる。

[0032]

なお、ダイオード46に代えてコンデンサを用いても良い。また、ダイオード46及び47によるクロストーク防止の構成は図4や図6のリセット動作機能を含まない構成にも加えることもできる。

また、上記した各実施例においては、1画素分の発光駆動回路を示しているが

、カラー表示の場合には、RGBの3つの発光駆動回路によって1画素分が形成 される。

[0033]

更に、上記した各実施例においては、表示パネルの発光駆動回路として構成されているが、本発明は単独の発光駆動回路であっても良い。単独の発光駆動回路の場合には走査パルスに代えて発光駆動回路のデータ書き込み用のスイッチ素子をオンさせるオン指令パルスが発光駆動回路には供給される。

[0034]

【発明の効果】

以上の如く、本発明によれば、データ信号書き込み用のスイッチ素子を大きく することなくデータ信号に応じた輝度で有機EL素子を発光させることができる

【図面の簡単な説明】

【図1】

有機EL素子の発光駆動回路の従来例を示す図である。

【図2】

本発明を適用した表示装置の構成を示すブロック図である。

【図3】

図2の表示装置中の走査パルス供給回路及びデータ信号供給回路の構成を示す ブロック図である。

【図4】

図2の表示装置の発光駆動回路の構成を示す回路図である。

【図5】

図4の発光駆動回路の動作を示すタイムチャートである。

【図6】

図2の表示装置の発光駆動回路の他の構成を示す回路図である。

【図7】

図6の発光駆動回路の動作を示すタイムチャートである。

【図8】

本発明を適用した他の表示装置の構成を示すブロック図である。 【図9】

図8の表示装置の発光駆動回路の構成を示す回路図である。

【図10】

図9の発光駆動回路の動作を示すタイムチャートである。

【図11】

図8の表示装置の発光駆動回路の他の構成を示す回路図である。

【図12】

図11の発光駆動回路の動作を示すタイムチャートである。

【図13】

図8の表示装置の発光駆動回路の他の構成を示す回路図である。

【図14】

図13の発光駆動回路の動作を示すタイムチャートである。

【図15】

図8の表示装置の発光駆動回路の他の構成を示す回路図である。

【図16】

図15の発光駆動回路の動作を示すタイムチャートである。

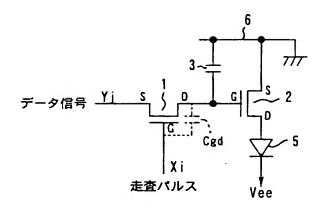
【符号の説明】

- 1, 2, 21, 41 FET
- 3, 23, 44 コンデンサ
- 5, 25, 45 有機EL素子
- 11,31 表示パネル
- 11<sub>1,1</sub>~11<sub>m,n</sub>, 31<sub>1,1</sub>~31<sub>m,n</sub> 発光駆動回路
- 12,32 走査パルス供給回路
- 13,33 データ信号供給回路

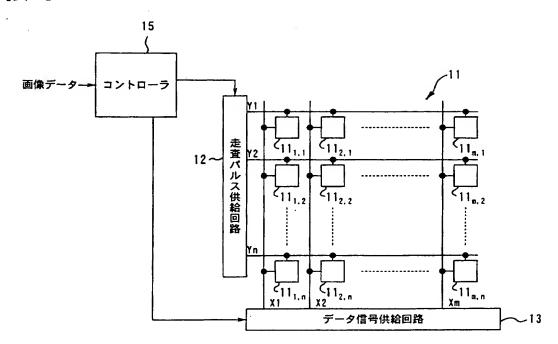
## 【書類名】

図面

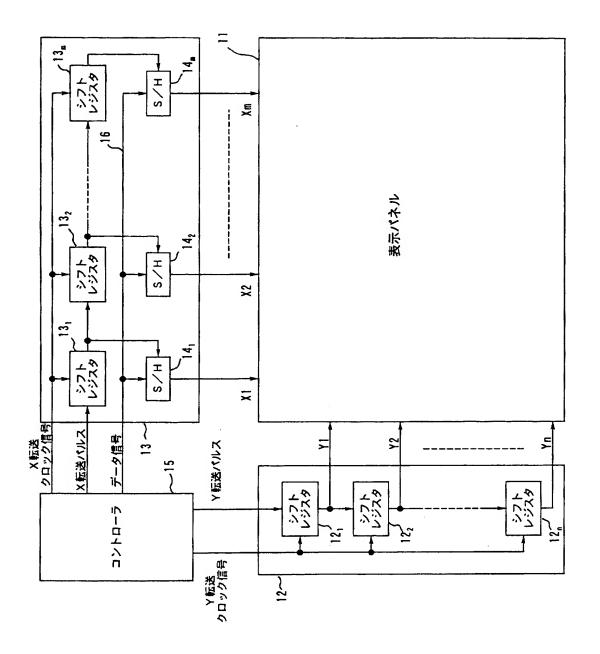
## 【図1】



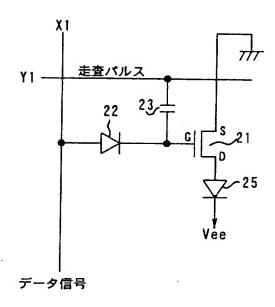
# 【図2】



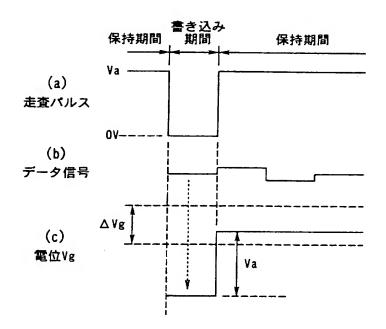
【図3】



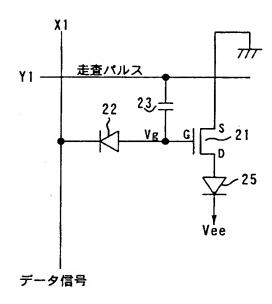
【図4】



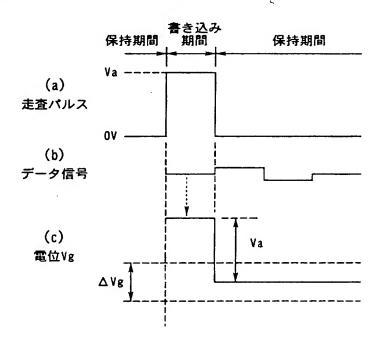
# 【図5】



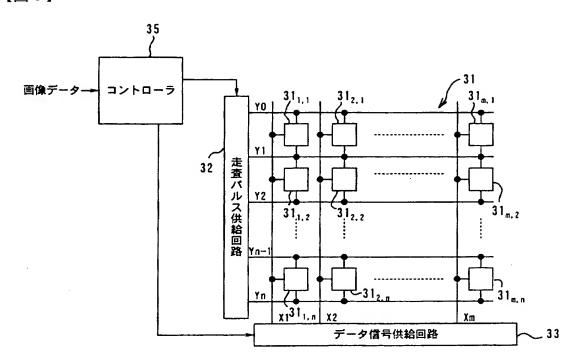
【図6】



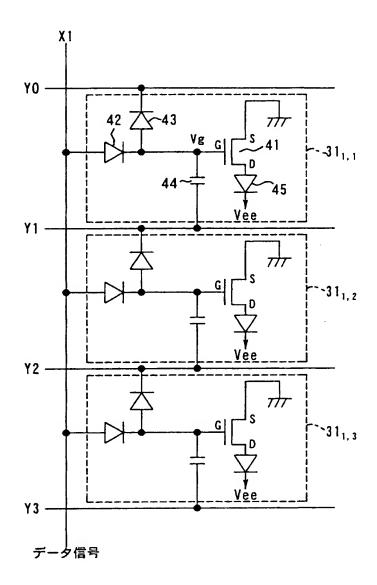
# 【図7】



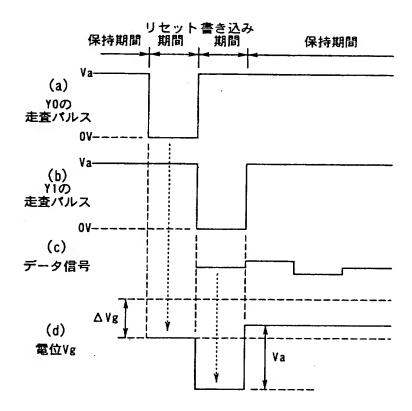
# 【図8】



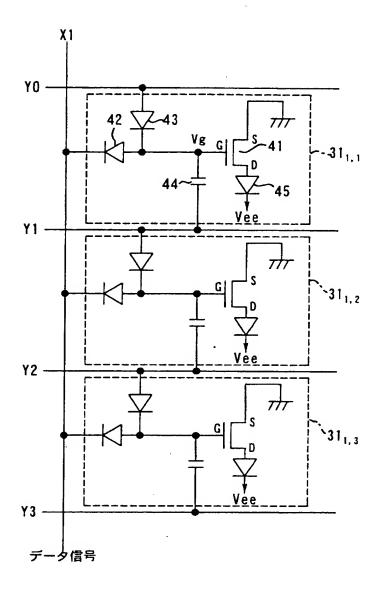
【図9】



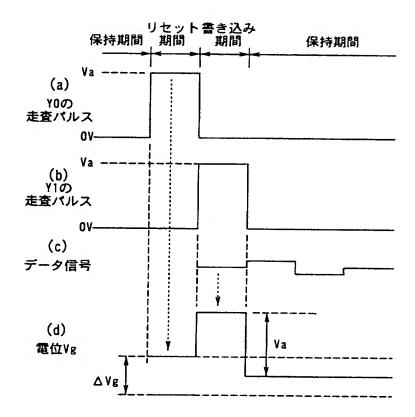
【図10】



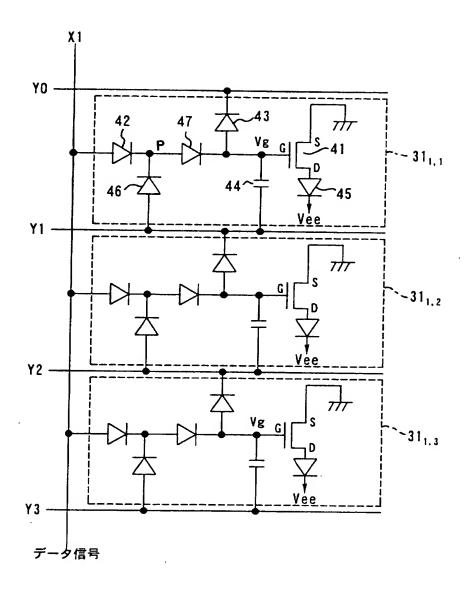
【図11】



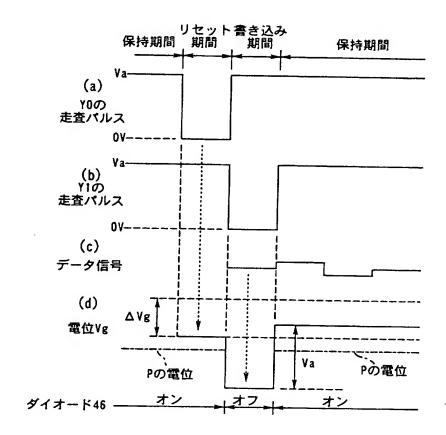
【図12】



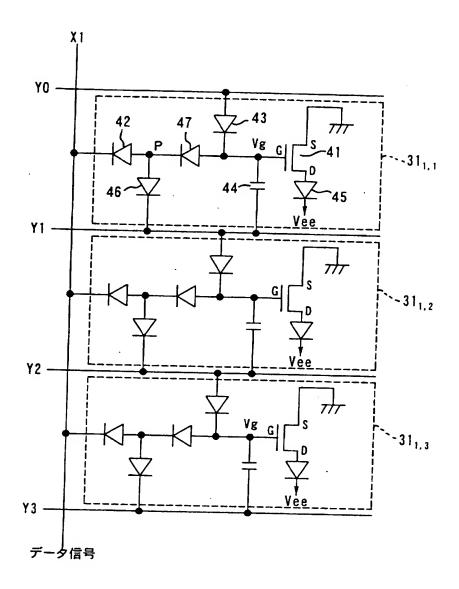
【図13】



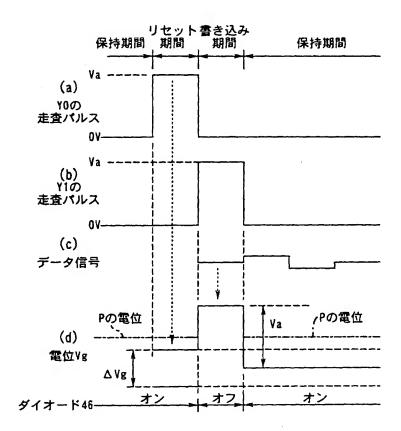
【図14】



【図15】



【図16】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 データ信号書き込み用のスイッチ素子を大きくすることなくデータ信号に応じた輝度で有機 E L 素子を発光させることができるアクティブ駆動方式の発光駆動回路及び表示装置を提供する。

【解決手段】 走査パルスに応じて導通状態となってデータ信号を通過させるスイッチ素子と、スイッチ素子の導通中にスイッチ素子を通過したデータ信号を保持する容量性素子と、容量性素子に保持されたデータ信号に応じて有機 E L 素子に順方向の駆動電流を供給して有機 E L 素子を発光させる駆動素子と、を備え、スイッチ素子は走査パルスが供給されたとき走査パルスとデータ信号との電位差によって導通状態となるダイオード素子からなる。

【選択図】 図4

## 出願人履歷情報

識別番号

[000005016]

1. 変更年月日

1990年 8月31日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都目黒区目黒1丁目4番1号

氏 名

パイオニア株式会社